








	<h2 style="color: red;">FQP12P20</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQP12P20</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 200V 11.5A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQP12P20.pdf</a> <a href="#">2.FQP12P20.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 26303 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQP12P20
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 200V 11.5A TO-220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	26303 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 200V 11.5A (Tc) 120W (Tc) Through Hole
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	120W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	470 mOhm @ 5.75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1200pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQP12P20 ist neu im Original, Suche FQP12P20 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP12P20 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP12P20: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQP12P10</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 11.5A TO-220</p>	 <p><b>FQP13N06</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 13A TO-220</p>	 <p><b>FQP13N06L</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 13.6A TO-220</p>	 <p><b>FQP12P20</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 11.5A TO-220</p>
 <p><b>FQP13N06L FQP13N06</b> Original FQP13N06L FQP13N06 Original</p>	 <p><b>FQP13N06L</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 13.6A TO-220</p>	 <p><b>FQP13N06</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 13A TO-220</p>	 <p><b>FQP12N60C</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 12A TO-220</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ FQP10N60B	↔ FQP10N60C	⇒ FQP10N60C	D FQP10N60CF	↔ FQP10N60C_07
⊥ FQP10N65	⊗ FQP10N65C	D FQP10N80	⇒ FQP11N40C	↔ FQP11N40C
⊗ FQP11N50CF	⊥ FQP11N50CF	⊗ FQP11N60	↔ FQP11N60C	↔ FQP11N65C
D FQP11P06	⊗ FQP11P06	⊥ FQP12N20	⊗ FQP12N60	↔ FQP12N60
⇒ FQP12N60C	↔ FQP12N60C	⊗ FQP12N65C	⊥ FQP12P10	↔ FQP12P10
↔ FQP12P20	⇒ FQP13N06	D FQP13N06	⊗ FQP13N06L	⊥ FQP13N06L
⊗ FQP13N10	D FQP13N10	⇒ FQP13N10L	↔ FQP13N10L	↔ FQP13N50
⊥ FQP13N50	⊗ FQP13N50C	↔ FQP13N50C	⇒ FQP13N60C	↔ FQP140N03
⊗ FQP140N03L	⊥ FQP14N15	⊗ FQP14N15	D FQP14N30	↔ FQP14N30
↔ FQP14N80	⊗ FQP14N80C	⊥ FQP15N16	⊗ FQP15N30	↔ FQP15N50

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited